

УМС®-01П

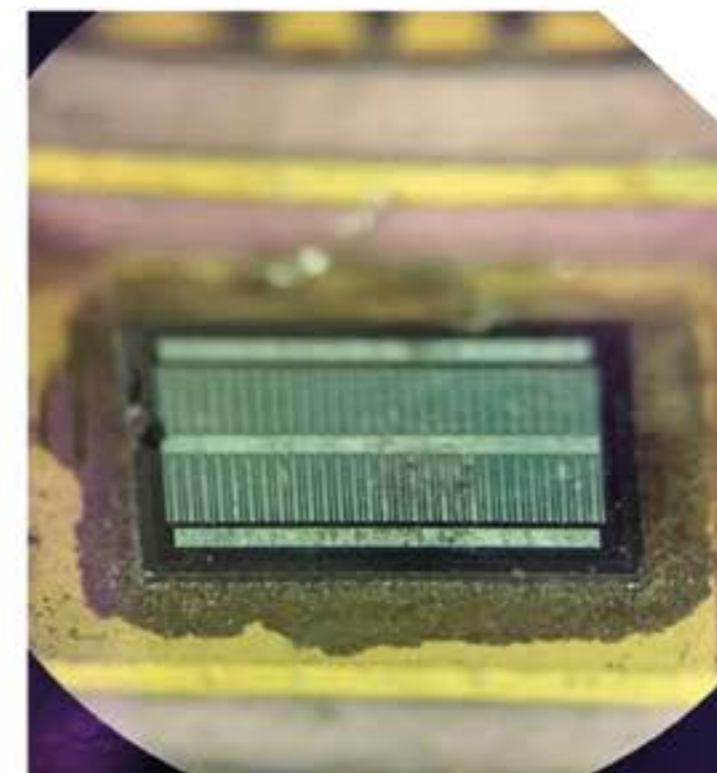
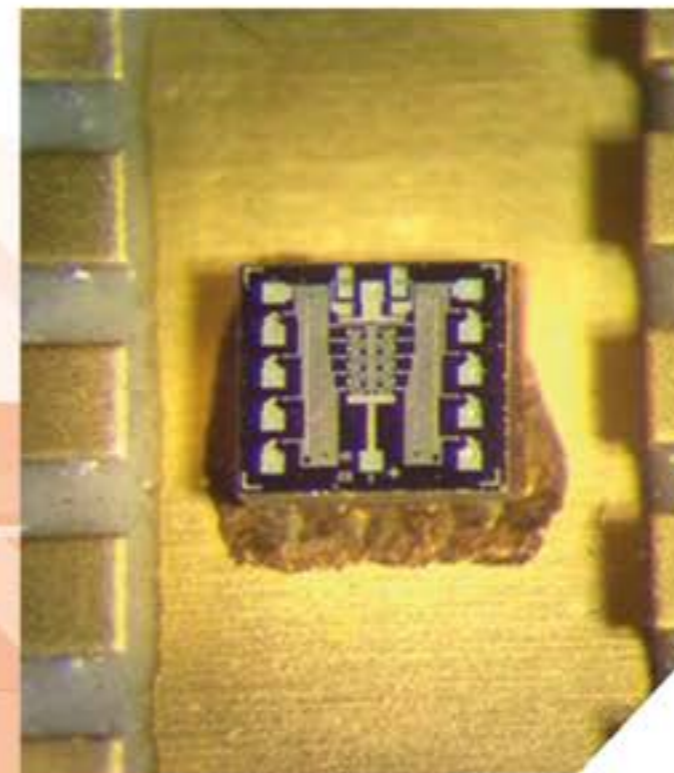
Механизированная установка монтажа полупроводниковых элементов (кристалла) с помощью эвтектической пайки

Установка предназначена для механизированного монтажа полупроводниковых кристаллов в корпус или на плату. Установка подходит для мелкосерийного производства изделия электронной техники. Установка позволяет производить монтаж полупроводниковых кристаллов с применением следующих технологий: – эвтектической пайки; – пайки без применения флюса. Расчетная производительность установки 3-3,5 тысячи приборов в смену.



Технологические возможности:

- Процессорный блок управления спrogramмируемым регулятором температуры предметного стола и технологического инструмента.
- Монтажная головка с регулируемым нагревом от «спирали» инструмента монтажа до 250 °С с возможностью перемещения по оси Z на 10 мм от механической педали.
- Оптическая головка ОГМЭ-Пз с фокусным расстоянием 90 мм и светодиодной подсветкой.
- Технологический нагревательный столик до 450° для размещения корпуса или платы для монтажа кристалла на эвтектику.
- Предметный стол «холодный» для взятия монтируемых кристаллов (со стекла).
- Микроманипулятор для перемещения монтажного столика по осям X, Y, с установленной на нем кареткой по оси X для ручной переброски предметных технологических столиков в зону монтажа, с возможностью перемещения на 130 мм.



Технические характеристики:

Размер присоединяемых кристаллов, мм	от 0,3х 0,3 до 10х10
Минимальная высота кристалла, мм	0,1
Ход манипулятора (прецизионное перемещение) по осям X, Y технологического столика с нагревом столика предназначенного для выборки кристалла, мм	15х15
Грубое ручное перемещение предметного стола по координатам X, Y и по углу F, мм/градусы	100х100 /360
Программируемая температура нагрева монтажного стола, °С	от 25 – 450
Регулируемая температура нагрева монтажной головки (призмы) °С	от 25 – 250
Амплитуда колебаний от электромагнитного привода монтажной головки при эвтектической пайке, мкм	100-1000
Точность монтажа полупроводникового кристалла в корпус или на плату относительно «реперных» знаков, мкм	±25
Диапазон регулирования усилия сжатия с помощью реки с грузом, Н	
1-2.5	
Настройка времени монтажа кристаллов при эвтектической пайки, мс	0,2-1000
Вакуум, кПа	от 25 до 30